

Na1—O4 ⁱⁱⁱ	2,402 (4)	Na4—O6 ⁱⁱⁱ	2,441 (5)
Na1—O2 ⁱⁱⁱ	2,512 (5)	Na4—O6 ⁱⁱⁱ	2,441 (5)
Na1—O2	2,512 (5)	Na4—O5 ⁱⁱ	2,631 (8)
O2—As1—O1	121.9 (3)	O5—Ti—O6 ⁱⁱ	88.3 (2)
O2—As1—O6	104.1 (2)	O5 ⁱⁱ —Ti—O6 ^{iv}	88.3 (2)
O1—As1—O6	107.8 (2)	O5—Ti—O6 ^v	91.7 (2)
O2—As1—O6 ⁱ	104.1 (2)	O6 ⁱⁱⁱ —Ti—O6 ^v	180.0
O1—As1—O6 ⁱ	107.8 (2)	O5 ⁱⁱ —Ti—O7 ⁱⁱⁱ	91.5 (2)
O6—As1—O6 ⁱ	111.0 (3)	O5—Ti—O7 ⁱⁱ	88.5 (2)
O4—As2—O3	120.2 (3)	O6 ⁱⁱⁱ —Ti—O7 ⁱⁱ	90.5 (2)
O4—As2—O7	109.5 (2)	O6 ^{iv} —Ti—O7 ⁱⁱ	89.5 (2)
O3—As2—O7	104.0 (2)	O5 ⁱⁱ —Ti—O7 ^{iv}	88.5 (2)
O4—As2—O7 ⁱ	109.5 (2)	O5—Ti—O7 ^v	91.5 (2)
O3—As2—O7 ⁱ	104.0 (2)	O6 ⁱⁱⁱ —Ti—O7 ^v	89.5 (2)
O7—As2—O7 ⁱ	109.2 (3)	O6 ^{iv} —Ti—O7 ^v	90.5 (2)
O5 ⁱⁱ —Ti—O5	180.0	O7 ⁱⁱⁱ —Ti—O7 ^v	180.0
O5 ⁱⁱ —Ti—O6 ⁱⁱ	91.7 (2)		

Codes de symétrie: (i) $x, -y, z$; (ii) $\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} - y, -z$; (iii) $\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} - y, 1 - z$; (iv) $x, y, z - 1$; (v) $-x, -y, 2 - z$; (vi) $x - \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2}, z$; (vii) $\frac{1}{2} - x, -\frac{1}{2} - y, 2 - z$; (viii) $\frac{1}{2} - x, y - \frac{1}{2}, 2 - z$; (ix) $-x, -y, 1 - z$; (x) $\frac{1}{2} - x, y - \frac{1}{2}, 1 - z$; (xi) $1 - x, -y, 1 - z$; (xii) $\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, z$; (xiii) $\frac{1}{2} + x, y - \frac{1}{2}, z$.

La largeur de balayage est $(0.50 + 0.60\text{tg}\theta)^\circ$. Les intensités ont été corrigées des facteurs de Lorentz–polarisation.

Collection des données: CAD-4 EXPRESS (Enraf–Nonius, 1992). Affinement des paramètres de la maille: CAD-4 EXPRESS. Réduction des données: MolEN (Fair, 1990). Programme(s) pour la solution de la structure: SHELXS86 (Sheldrick, 1990). Programme(s) pour l'affinement de la structure: SHELXL93 (Sheldrick, 1993). Logiciel utilisé pour préparer le matériel pour publication: SHELXL93.

Des documents complémentaires concernant cette structure peuvent être obtenus à partir des archives électroniques de l'UICr (Référence: BR1184). Les processus d'accès à ces archives sont donnés au dos de la couverture.

Références

- Abramov, Y. A., Tsirelson, V. G., Zavodnik, V. E., Ivanov, S. A. & Brown, I. D. (1995). *Acta Cryst. B51*, 942–951.
 Bolotina, N. B., Maksimov, B. A., Tamazyan, R. A. & Klokočova, N. E. (1993). *Crystallogr. Rep. 38*, 451–454.
 Bolotina, N. B., Maximov, B. A., Petricek, V. & Simonov, V. I. (1995). *Crystallogr. Rep. 40*, 560–573.
 Buttner, R. H. & Maslen, E. N. (1992). *Acta Cryst. B48*, 764–769.
 Donnay, J. D. H. & Ondik, H. M. (1973). *Crystal Data Determinative Tables*, Tome II, 3ème édition, p. M49. National Bureau of Standards: Washington DC.
 El Brahim, M. & Durand, J. (1986). *Rev. Chim. Miner. 23*, 146–153.
 Enraf–Nonius (1992). CAD-4 EXPRESS. Version 1.1. Enraf–Nonius, Delft, Les Pays-Bas.
 Fair, C. K. (1990). *MOLEN. An Interactive Intelligent System for Crystal Structure Analysis*. Enraf–Nonius, Delft, Les Pays-Bas.
 Gonsiorek, W. (1982). *Z. Kristallogr. 160*, 187–203.
 Gonsiorek, W. & Feld, R. (1982). *Z. Kristallogr. 161*, 1–5.
 Guyomard, D., Pagnoux, C., Zah Letho, J. J., Verbaere, A. & Piffard, Y. (1991). *J. Solid State Chem. 90*, 367–372.
 Haddad, A., Jouini, T. & Piffard, Y. (1992). *Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 29*, 57–63.
 Hagman, L. & Kierkegaard, P. (1968). *Acta Chem. Scand. 22*, 1822–1832.
 Higgins, J. B. & Ribbe, P. H. (1977). *Am. Miner. 62*, 801–806.
 Hollabaugh, C. L. & Foit, F. F. Jr (1984). *Am. Miner. 69*, 725–732.
 Howard, C. J., Sabine, T. M. & Dickson, F. (1991). *Acta Cryst. B47*, 462–468.
 Johnson, C. K. (1965). ORTEP. Rapport ORNL-3794. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, EU.

- Klokočova, N. E., Maksimov, B. A. & Tamazyan, R. A. (1993). *Crystallogr. Rep. 38*, 454–456.
 Lii, K. H., Li, C. H., Cheng, C. Y. & Wang, S. L. (1991). *J. Solid State Chem. 95*, 352–359.
 Maksimov, B. A., Klokočova, N. E., Verin, I. A. & Timofeeva, V. A. (1990). *Sov. Phys. Crystallogr. 35*, 497–500.
 Maximov, B. A., Bolotina, N. B., Simonov, V. I., Petricek, V. & Schulz, H. (1994). *Acta Cryst. B50*, 261–268.
 Maximov, B., Bolotina, N. & Tamazyan, R. (1994). *Z. Kristallogr. 209*, 649–656.
 North, A. C. T., Phillips, D. C. & Mathews, F. S. (1968). *Acta Cryst. A24*, 351–359.
 Phillips, M. L. F., Harrison, W. T. A., Stucky, G. D., McCarron, E. M. III, Calabrese, J. C. & Gier, T. E. (1992). *Chem. Mater. 4*, 222–233.
 Protas, J., Marnier, G., Boulanger, B. & Menaert, B. (1989). *Acta Cryst. C45*, 1123–1125.
 Reid, A. F., Wadsley, A. D. & Sienko, M. J. (1968). *Inorg. Chem. 7*, 112–118.
 Remy, F., Monnereau, O. & Casalot, A. (1988). *J. Solid State Chem. 76*, 167–177.
 Robertson, A., Fletcher, J. G., Skakle, J. M. S. & West, A. R. (1994). *J. Solid State Chem. 109*, 53–59.
 Seki, H., Ishizawa, N., Mizutani, N. & Kato, M. (1984). *Yogyo Kyokai Shi (J. Ceram. Assoc. Jpn.) 92*, 219–223.
 Sheldrick, G. M. (1990). *Acta Cryst. A46*, 467–473.
 Sheldrick, G. M. (1993). *SHELXL93. Program for the Refinement of Crystal Structures*. Université de Göttingen, Allemagne.
 Sugiyama, K. & Takeuchi, Y. (1991). *Z. Kristallogr. 194*, 305–313.
 Swope, R. J., Smyth, J. R. & Larson, A. C. (1995). *Am. Miner. 80*, 448–453.
 Tamazyan, R. A., Maksimov, B. A., Bolotina, N. B., Novikova, N. E. & Simonov, V. I. (1994). *Crystallogr. Rep. 39*, 422–427.
 Thomas, P. A., Mayo, S. C. & Watts, B. E. (1992). *Acta Cryst. B48*, 401–407.
 Tordjman, I., Masse, R. & Guitel, J. C. (1974). *Z. Kristallogr. 139*, 103–115.
 Yaakoubi, A., Jouini, T. & Jouini, N. (1991). *C. R. Acad. Sci. Paris, 312*, 451–453.
 Zumesteg, F. C., Bierlein, J. D. & Gier, T. E. (1976). *J. Appl. Phys. 47*, 4980–4985.

Acta Cryst. (1998). C54, 1202–1204

Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇

AMOR HADDAD,^a HABIB BOUGHZALA^b ET TAHAR JOUINI^b

^aDépartement de Chimie, Faculté des Sciences de Monastir, 5000 Monastir, Tunisie, et ^bDépartement de Chimie, Faculté des Sciences, 1060 Campus Universitaire, Tunis, Tunisie.
 E-mail: tahar.jouini@fst.rnu.tn

(Reçu le 18 décembre 1996, accepté le 16 mai 1997)

Abstract

The three-dimensional network structure of the title compound (arsenic caesium vanadium oxide) comprises VO₅ pyramids and (As,V)₂O₇ groups sharing corners to form puckered layers. The layers are linked to each other by chains of VO₆ octahedra. The framework exhibits

large tunnels parallel to the *b* axis interconnected with other smaller tunnels which are parallel to the *c* axis. The Cs⁺ ions are located at the intersections of these tunnels. Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇ is isostructural with Cs₂V₃P₄O₁₇ [Lii *et al.* (1989). *J. Solid State Chem.* **80**, 127–132].

Commentaire

La comparaison de cette structure avec celles des composés A₂VOP₂O₇ (A = Rb, Cs; Lii & Wang, 1989) permet d'établir une filiation. En effet, on peut passer de la structure bidimensionnelle de A₂VOP₂O₇ à celle tridimensionnelle de Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇ par mise en commun d'atomes d'oxygène des tétraèdres (As,V)^{VO₄} avec des chaînes d'octaèdres VO₆ (Fig. 1). Ceci nécessite une réorientation des tétraèdres de manière à diriger leurs atomes d'oxygène libres vers le vanadium.

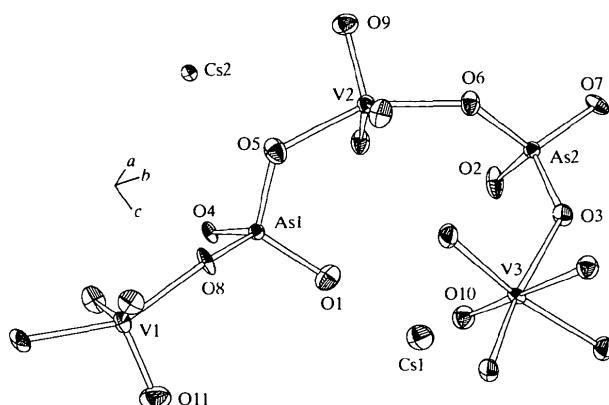


Fig. 1. Projection dans la direction [010] de la structure de Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇. Les ellipsoïdes de vibration des atomes ont une probabilité de 50%.

Un rapprochement structural peut également être effectué avec CsVP₂O₇ (Wang & Lii, 1989) qui manifeste l'existence de couches [VP₂O₇]_n analogues à celles observées dans le composé étudié (Fig. 2). Les deux structures diffèrent par le mode de connexion des couches qui s'opère dans CsVP₂O₇ par mise en commun de l'atome d'oxygène libre d'un tétraèdre de chaque groupement P₂O₇ avec le vanadium d'une couche voisine, la coordinence de ce dernier passant de 5 à 6. Enfin la comparaison de Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇, tridimensionnel avec le composé bidimensionnel: Na₂VOP₂O₇ (Ben Hamada *et al.*, 1992) révèle que ce dernier comporte des couches analogues qui diffèrent de celles décrites dans ce travail, par la mise en commun d'un atome d'oxygène libre de PO₄ avec un vanadium de la même couche, avec pour conséquences l'adoption de la conformation décalée par P₂O₇ et le passage du vanadium de la coordinence 5 à la coordinence 6.

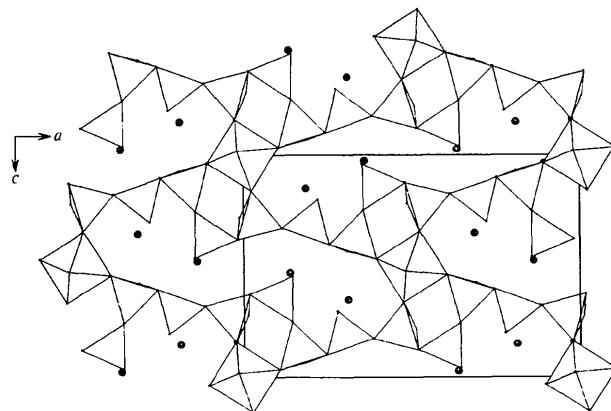


Fig. 2. Projection dans la direction [001] d'une couche de tétraèdres (As,V)^{VO₄} et de pyramides VO₅ dans la structure de Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇.

Partie expérimentale

Un mélange de V₂O₅ et Cs₂CO₃ dans une solution de H₃AsO₄ (*d* = 2,05; 80,5%) dans le rapport Cs:V:As 1:1:2 a été effectué, l'objectif initial étant de préparer Cs₂VAs₂O₇. La solution obtenue est ensuite évaporée à sec par chauffage sur une plaque chauffante. Le résidu solide résultant est porté à la fusion à 953 K au four à moufle, puis ramené lentement à la température ambiante. Le solide obtenu est lavé à l'eau bouillante pour dissoudre la masse vitreuse. Des cristaux de couleur verte, de formes et de dimensions variables, sont ainsi isolés.

Données cristallines

Cs₂V₃(As_{0.635}V_{0.365})₄O₁₇

M_r = 955,31

Orthorhombique

Pnma

a = 18,005 (3) Å

b = 7,497 (3) Å

c = 11,796 (2) Å

V = 1592,3 (7) Å³

Z = 4

D_x = 3,985 Mg m⁻³

Radiation Mo *K*α

λ = 0,71069 Å

Paramètres de la maille à l'aide de 25 réflexions

θ = 5–17°

μ = 12,361 mm⁻¹

T = 293 (2) K

Bâtonnet

0,2 × 0,07 × 0,07 mm

Vert

Collection des données

Diffractomètre CAD-4

Balance ω/2θ

Correction d'absorption:

empirique via balayage

ψ (North *et al.*, 1968)

T_{min} = 0,30, *T_{max}* = 0,42

1512 réflexions mesurées

1512 réflexions

indépendantes

1079 réflexions avec

F_o > 4σ(*F_o*)

θ_{max} = 24,98°

h = -21 → 0

k = -8 → 0

l = 0 → 14

1 réflexion de référence

fréquence: 120 min

variation d'intensité:

0,86%

Affinement

Affinement à partir des *F²*
R[*F²* > 2σ(*F²*)] = 0,031

Δρ_{max} = 1,02 e Å⁻³

Δρ_{min} = -1,16 e Å⁻³

$wR(F^2) = 0,068$
 $S = 1,133$
1512 réflexions
141 paramètres
 $w = 1/[\sigma^2(F_o^2) + (0,0233P)^2]$
où $P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$
 $(\Delta/\sigma)_{\text{max}} = 0,004$

Correction d'extinction:
SHELXL93 (Sheldrick, 1993)
Coefficient d'extinction:
0,00035 (7)
Facteurs de diffusion des
*International Tables for
Crystallography* (Tome C)

Des documents complémentaires concernant cette structure peuvent être obtenus à partir des archives électroniques de l'UICr (Référence: DU1175). Les processus d'accès à ces archives sont donnés au dos de la couverture.

Tableau 1. Paramètres géométriques (\AA , °)

Cs1—O3	3,062 (5)	(As,V)1—O5	1,630 (5)
Cs1—O3 ⁱ	3,062 (5)	(As,V)1—O8	1,635 (4)
Cs1—O9 ⁱⁱ	3,275 (7)	(As,V)1—O4	1,719 (3)
Cs1—O1 ⁱⁱⁱ	3,318 (5)	(As,V)2—O3	1,613 (5)
Cs1—O1 ^{iv}	3,318 (5)	(As,V)2—O7	1,627 (5)
Cs1—O8 ⁱⁱⁱ	3,386 (5)	(As,V)2—O6	1,644 (5)
Cs1—O8 ^{iv}	3,386 (5)	(As,V)2—O2	1,716 (3)
Cs1—O7 ⁱ	3,425 (5)	V1—O11 ^x	1,583 (8)
Cs1—O7	3,425 (5)	V1—O7 ^{xii}	1,983 (5)
Cs1—O6 ^y	3,551 (5)	V1—O7 ^{xiii}	1,983 (5)
Cs1—O6 ⁱⁱ	3,551 (5)	V1—O8	1,989 (5)
Cs2—O4 ^{vi}	3,201 (7)	V1—O8 ⁱ	1,989 (5)
Cs2—O11	3,250 (7)	V2—O9	1,593 (7)
Cs2—O2 ^{vii}	3,293 (7)	V2—O5	1,967 (5)
Cs2—O8 ^v	3,344 (5)	V2—O5 ^{xiii}	1,967 (5)
Cs2—O8 ⁱⁱ	3,344 (5)	V2—O6 ^{xiii}	1,972 (5)
Cs2—O5 ^{viii}	3,431 (5)	V2—O6	1,972 (5)
Cs2—O5 ^{vi}	3,431 (5)	V3—O10 ⁱⁱⁱ	1,636 (3)
Cs2—O7 ^{ix}	3,486 (5)	V3—O1 ^y	1,979 (9)
Cs2—O7 ^{vii}	3,486 (5)	V3—O3 ⁱ	1,985 (9)
Cs2—O6 ^{viii}	3,522 (5)	V3—O3 ^v	1,992 (8)
Cs2—O6 ^{vi}	3,522 (5)	V3—O1 ⁱ	1,993 (9)
Cs2—O5 ^v	3,561 (5)	V3—O10 ^{xiv}	2,190 (3)
(As,V)1—O1	1,619 (5)		
O1—(As,V)1—O5	111,2 (3)	O5—V2—O5 ^{xiii}	85,2 (3)
O1—(As,V)1—O8	111,2 (2)	O9—V2—O6 ^{xiii}	103,1 (2)
O5—(As,V)1—O8	109,4 (2)	O5—V2—O6 ^{xiii}	153,0 (2)
O1—(As,V)1—O4	109,8 (3)	O5 ^{xiii} —V2—O6 ^{xiii}	86,4 (2)
O5—(As,V)1—O4	105,7 (3)	O9—V2—O6	103,1 (2)
O8—(As,V)1—O4	109,4 (3)	O5—V2—O6	86,4 (2)
O3—(As,V)2—O7	109,6 (3)	O5 ^{xiii} —V2—O6	153,0 (2)
O3—(As,V)2—O6	115,9 (3)	O6 ^{xiii} —V2—O6	89,5 (3)
O7—(As,V)2—O6	114,5 (2)	O10 ^{xiii} —V3—O1 ^v	96,3 (4)
O3—(As,V)2—O2	107,3 (3)	O10 ^{xiii} —V3—O3 ⁱ	97,4 (4)
O7—(As,V)2—O2	100,9 (3)	O1 ^{iv} —V3—O3 ⁱ	87,1 (4)
O6—(As,V)2—O2	107,2 (3)	O10 ^{xiii} —V3—O3 ^{iv}	98,6 (4)
O11 ^x —V1—O7 ^{xii}	103,0 (2)	O1 ^{iv} —V3—O3 ^{iv}	91,1 (4)
O11 ^x —V1—O7 ⁱⁱ	103,0 (2)	O3 ⁱ —V3—O3 ^{iv}	164,0 (2)
O7 ^{xii} —V1—O7 ^{xii}	89,8 (3)	O10 ^{xiii} —V3—O1 ⁱ	99,8 (4)
O11 ^x —V1—O8	103,5 (2)	O1 ^{iv} —V3—O1 ⁱ	164,0 (2)
O7 ^{xii} —V1—O8	153,5 (2)	O3 ⁱ —V3—O1 ⁱ	90,9 (4)
O7 ^{xii} —V1—O8	83,5 (2)	O3 ^{iv} —V3—O1 ⁱ	86,5 (4)
O11 ^x —V1—O8 ⁱ	103,5 (2)	O10 ^{xiii} —V3—O10 ^{xiv}	179,9 (4)
O7 ^{xii} —V1—O8 ⁱ	83,5 (2)	O1 ^{iv} —V3—O10 ^{xiv}	83,7 (3)
O7 ^{xii} —V1—O8 ⁱ	153,5 (2)	O3 ⁱ —V3—O10 ^{xiv}	82,6 (3)
O8—V1—O8 ⁱ	91,1 (3)	O3 ^{iv} —V3—O10 ^{xiv}	81,3 (3)
O9—V2—O5	103,8 (2)	O1 ⁱ —V3—O10 ^{xiv}	80,3 (3)
O9—V2—O5 ^{xiii}	103,9 (2)		

Codes de symétrie: (i) $x, \frac{1}{2} - y, z$; (ii) $\frac{1}{2} - x, y - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + z$; (iii) $-x, 1 - y, -z$; (iv) $-x, y - \frac{1}{2}, -z$; (v) $\frac{1}{2} - x, 1 - y, \frac{1}{2} + z$; (vi) $\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, -\frac{1}{2} - z$; (vii) $1 - x, 1 - y, -z$; (viii) $\frac{1}{2} + x, y, -\frac{1}{2} - z$; (ix) $1 - x, y - \frac{1}{2}, -z$; (x) $x - 1, y, z$; (xi) $x - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - y, -\frac{1}{2} - z$; (xii) $x - \frac{1}{2}, y, -\frac{1}{2} - z$; (xiii) $x, \frac{3}{2} - y, z$; (xiv) $x, y - 1, z$.

Collection des données: *CAD-4 EXPRESS* (Duisenberg, 1992; Macícek & Yordanov, 1992). Affinement des paramètres de la maille: *CAD-4 EXPRESS*. Réduction des données: *MolEN* (Fair, 1990). Programme(s) pour la solution de la structure: *SHELXS86* (Sheldrick, 1990). Programme(s) pour l'affinement de la structure: *SHELXL93* (Sheldrick, 1993). Logiciel utilisé pour préparer le matériel pour publication: *SHELXL93*.

Références

- Ben Hamada, L., Grandin, A., Borel, M. M., Leclaire, A. & Raveau, B. (1992). *J. Solid State Chem.* **101**, 154–160.
Duisenberg, A. J. M. (1992). *J. Appl. Cryst.* **25**, 92–96.
Fair, C. K. (1990). *MolEN. An Interactive Intelligent System for Crystal Structure Analysis*. Enraf–Nonius, Delft, Les Pays-Bas.
Lii, K. H. & Wang, S. L. (1989). *J. Solid State Chem.* **82**, 239–246.
Lii, K. H., Wang, Y. P. & Wang, S. L. (1989). *J. Solid State Chem.* **80**, 127–132.
Macícek, J. & Yordanov, A. (1992). *J. Appl. Cryst.* **25**, 73–80.
North, A. C. T., Phillips, D. C. & Mathews, F. S. (1968). *Acta Cryst.* **A24**, 351–359.
Sheldrick, G. M. (1990). *Acta Cryst.* **A46**, 467–473.
Sheldrick, G. M. (1993). *SHELXL93. Program for the Refinement of Crystal Structures*. Université de Göttingen, Allemagne.
Wang, Y. P. & Lii, K. H. (1989). *Acta Cryst.* **C45**, 1210–1211.

Acta Cryst. (1998). **C54**, 1204–1206

Electrochemically Lithiated Vanadium Oxide, $\text{Li}_3\text{V}_6\text{O}_{13}$

ÖRJAN BERGSTRÖM, TORBJÖRN GUSTAFSSON AND JOHN O. THOMAS

Inorganic Chemistry, The Ångström Laboratory, Uppsala University, Box 538, S-751 21 Uppsala, Sweden. E-mail: torbjorn.gustafsson@kemi.uu.se

(Received 20 October 1997; accepted 18 March 1998)

Abstract

Single crystals of V_6O_{13} were grown by chemical vapour transport (CVT) and subsequently electrochemically lithiated. The title compound, trilithium hexavanadium tridecaoxide, was the phase formed during electrochemical lithiation at 2.45 V versus Li/Li^+ . The $\text{Li}_3\text{V}_6\text{O}_{13}$ structure comprises single and double layers of VO_6 octahedra stacked in the c direction. Lithiation results in a 6.5% expansion along the b axis with respect to V_6O_{13} . Li atoms are located in two types of crystallographically independent sites: (i) a fully occupied $4i$ site with fivefold square-pyramidal O-atom coordination [Li—O distances in the range 1.960 (1)–2.031 (5) Å]; (ii) one 50% occupied $4i$ site with planar quadratic O-atom coordination [Li—O distances in the range 1.99 (1)–2.08 (5) Å].